PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-138067

(43) Date of publication of application: 30.05.1995

(51)Int.CI.

C04B 35/18 CO4B 35/00 F02C 7/20 HO1M

(21)Application number: 06-083816

(71)Applicant: NHK SPRING CO LTD

(22)Date of filing:

29.03.1994

(72)Inventor: SATO SHIGEMI

AKI MINCHIYORU

KOBAYASHI YASUYOSHI

ANDOU CHIYUU

(30)Priority

Priority number: 05263003

Priority date: 27.09.1993

Priority country: JP

(54) CERAMIC SPRING MATERIAL AND CERAMIC SPRING AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a ceramic spring causing no decline in its mechanical strength even in an atmosphere at elevated temperatures, low in elastic modulus, and improved in both fracture stress and flexural strength, by heat treatment of a composite sintered compact prepared by dispersing fine carbide particles in a matrix consisting of mullite.

CONSTITUTION: Firstly, a matrix consisting of mullite is subjected to wet mixing with fine powder of at least one kind of carbide selected from among TiC, SiC, VC, NbC, B4C, TaC, WC, HfC, Cr2C2 and ZrC, followed by drying into mixed powder. Second, the mixed powder is hot-pressed to produce a composite sintered compact, which is then heat treated at temperatures ≥1200°C but not higher than the sintered temperature to obtain the objective ceramic spring material. Finally, this material is formed to a desired shape to obtain the other objective ceramic spring.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.07.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 03.03.1998

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2813132

[Date of registration]

07.08.1998

[Number of appeal against examiner's decision of

10-05214

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

02.04.1998

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(川)特許出願公開發号

特開平7-138067

(43)公開日 平成7年(1995)5月30日

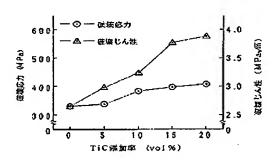
(51) Int.CL*	織別起号	庁内整理番号	PI		技術表示管所
CO4B 35/18					
35/00					
# F02C 7/20	Z		•		
			C04B	35/ 18	
				35/ 00 H	
		審查商求	來簡 來商未	頭の数4 FD (全 5 頁)	最終頁に続く
(21)出癩番号	特顯平6-83816		(71)出顧人	000004640	
				日本発条株式会社	
(22)出題日	平成6年(1994)3月	29 El		神奈川県横浜市金沢区福清 9	丁目10番池
			(72) 発明者	佐藤 繁美	
(31)優先権主張番号	特醫平5-263003			神奈川県横浜市金沢区福浦3	丁月10番地
(32)優先日	平5 (1998) 9月27日			日発グループ中央研究所内	
(33) 優先権主張国	日本 (JP)		(72) 発明者	秋 ▲ミン▼▲チョル▼	
				神奈川県横浜市西区中央27	7月48-7 堂
				中含4F-B	
			(72) 発明者	小林 康良	
				神奈川県横浜市金沢区福清 9	丁目10番池
				自発グループ中央研究所内	
			(74)代理人	护理士 大岛 陽一	
					最終質に続く

(54) 【発明の名称】 セラミックばわ材並びにセラミックばね及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】 セラミックはね付を、1000で以上高温の 雰囲気でも破骸低下せずかつ安定して使用可能にする。 【構成】セラミックはね付を、平均粒径0.2μmのム ライト粉末(A1,0,の含有率71.8元%)に、平均粒径 1.30μmのT・C粉末を所定置配合し、アルコール 中でナイロンボールを用いて24時間還式混合した後、 エバボレータで溶媒を抽出し、さらに真空乾燥炉を用い で乾燥させて、混合粉末を調整し、この粉末を、焼縮温 度1650で4時間、N,ガス雰囲気中で、圧力35 MPaでホットプレスして、ムライト中に微細な炭化物 粒子を分散させた複合焼結体として、所望の形状のばね を製作する。さらに、熱処理を行うと良い。

【効果】高温度まで強度劣化せずかつ低い弾性率を有するムライトを用い、強度・じん性を向上し、より一層高温の雰囲気で使用可能にする。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ムライトからなるマトリクスに炭化物の 微細粒子を分散してばわ村を形成したことを特徴とする セラミックはね付。

【請求項2】 前記微細粒子が、TiC、SiC V C. NbC, B.C, TaC, WC. HfC, Cr gC1. 2 r Cの少なくとも 1 種類以上からなることを特 **徴とする請求項1に記載のセラミックばわ材。**

【語求項3】 請求項1若しくは請求項2に記載のセラ ミックばわ材からなることを特徴とするセラミックは **\$2.**

【調求項4】 ムライトからなるマトリクスに炭化物の 微細粒子を分散させた彼合規結体を製作する過程と、前 記接合烧縮体を1200℃以上烧結温度以下で熱処理す る過程とを有することを特徴とするセラミックばねの製 造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、セラミックばね付並び の雰囲気で使用するのに直するセラミックばわ対並びに セラミックばね及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のセラミックはねの材料には、部分 安定化ジルコニアや塩化けい素が用いられていた。部分 安定化ジルコニアは、酸化物セラミックスであり、応力 誘起マルテンサイト変態を利用した強靭化構造により、 **室温で高強度であるが、高温では強度が低下し、耐熱性** に劣るという欠点がある。また、窒化けい素は、非酸化 物であり、焼結後の結晶位形状が柱状晶であることか ら、強靭な材料であり、さらに1000℃程度までほと んど強度低下しない。しかしながら、より一層高温にな ると、焼結助剤として添加した酸化物セラミックス(A I₂O₃、MgO, CeO, Y₂O₂)の影響により強度低 下するばかりでなく、非酸化物であるため、高温(10 る.

【0003】とのように従来のセラミックはね付として の部分安定化ジルコニアや窒化けい素にあっては、10 0.0°C以上の高温の雰囲気で安定して使用することがで きなく、セラミックばねを各種高温装置に使用すること ができないという問題があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このような従来技術の 問題点に鑑み、本発明の主な目的は、1000℃以上の 高温の雰囲気でも強度低下せずかつ安定して使用可能な セラミックばね付並びにセラミックばね及びその製造方 法を提供することにある。

[00051

【課題を解決するための手段】このような目的は、本発 50 とができる。

明によれば、ムライトからなるマトリクスに炭化物の微 細粒子を分散してばわ材を形成したことを特徴とするセ ラミックばわ付を提供することにより達成される。 特 B.C. TaC. WC. HfC. Cr.C. ZrCの少 なくとも1種類以上からなると良い。また、前記セラミ ックばね材からなるセラミックばね. あるいは. ムライ トからなるマトリクスに炭化物の微細粒子を分散させた 複合競結体を製作する過程と、前記複合機結体を120 0℃以上烧結温度以下(好ましくは1200℃以上14 0.0℃以下〉で熱処理する過程とを有することを特徴と するセラミックばねの製造方法を提供することにより達 成される。

2

[0006]

【作用】このように、弾性率が低くばねのようなたわみ を要求するものに適合し、かつ高温度(約1400℃) まで強度劣化しない材料としてのムライト(3A1,0, - 2 S · O₂ 〉中に微細な炭化物粒子を分散させること により、ムライトと炭化物粒子との間の熱膨張差により にセラミックばね及びその製造方法に関し、特に、高温 20 残留応力が発生し、強靭化されると共に、マトリックス であるムライト結晶の粒径よりもかなり小さい粒径の炭 化物粒子がムライト結晶の粒内にも存在して、マトリッ クスを強化し、また、粒径の大きな粒子が粒界に存在し で、クラックの進行を妨げることにより強靭化し得る。 また。ムライト中に微細な炭化物粒子を分散させた複合 焼結体を所望の形状に加工し、1200℃以上競結温度 以下(好ましくは1200℃以上1400℃以下)で熱 処理してセラミックばねを形成することにより、強度を 高め得る。

[0007]

【実施例】以下、本発明の好適実施例を詳しく説明す **る**.

【0008】本発明が適用されるセラミックはねは、高 温や腐食性ガスの雰囲気で使用されるばわとして用いる のに適するものであり、例えば、ガスターピンや固体総 料電池の高温装置に於ける熱膨張吸収用ばねとして用い ちれる.

【りり09】上記ばわの付料としてのセラミックばわ材 は、ムライト (3A!,O,・2S!O,) 中に微細な炭 化物粒子としてのTICを添加して作られる。例えば、 平均位径(). 2 μmのムライト粉末 (A.), O,の含有率 71.8m%) に、平均粒径1、30 μmのT 1 C 粉末を所 定量配合し、アルコール中でナイロンボールを用いて2 4時間湿式混合した後、エバボレータで溶媒を抽出し、 更に真空乾燥炉を用いて乾燥させて、 舞台粉末を調整す る。この粉末を焼結温度1650℃で4時間、N₂ガス 雰囲気中で、圧力35MPaでホットプレスして、ムラ イト中に微細な炭化物粒子を分散させた複合焼結体を製 作する。上記焼結体から所望の形状のばねを製作するこ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ムライトからなるマトリクスに炭化物の 微細粒子を分散してばわ村を形成したことを特徴とする セラミックばね村。

【請求項2】 前記微細粒子が、TiC、SiC. V C. NbC, B,C, TaC, WC. HfC, Cr 。C. 2rCの少なくとも1種類以上からなることを特 欲とする請求項1に記載のセラミックばわ材。

【請求項3】 請求項1若しくは請求項2に記載のセラ ミックはわ材からなることを特徴とするセラミックは ts.

【諄求項4】 ムライトからなるマトリクスに炭化物の 微細粒子を分散させた複合結結体を製作する過程と、前 記複合焼結体を1200°C以上焼結温度以下で熱処理す る過程とを有することを特徴とするセラミックばねの製 造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、セラミックばね付並び にセラミックばね及びその製造方法に関し、特に、高温 20 の雰囲気で使用するのに適するセラミックばね付並びに セラミックばね及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のセラミックばねの材料には、部分 安定化ジルコニアや窒化けい素が用いられていた。部分 安定化ジルコニアは、酸化物セラミックスであり、応力 誘起マルテンサイト変感を利用した強靭化構造により、 室温で高強度であるが、高温では強度が低下し、耐熱性 に劣るという欠点がある。また、窒化けい素は、非酸化 物であり、焼結後の結晶粒形状が柱状晶であることか ら、強靭な材料であり、さらに1000℃程度までほと んど強度低下しない。しかしながら、より一層高温にな ると、焼結助剤として添加した酸化物セラミックス(A 1,O₂、MgO, CeO, Y,O₃) の影響により強度低 下するばかりでなく、非酸化物であるため、高温(10) ○ ○ で以上)の雰囲気では酸化劣化するという欠点があ る.

【0003】とのように従来のセラミックはね付として の部分安定化ジルコニアや窒化けい素にあっては、10 0.0℃以上の高温の雰囲気で安定して使用することがで 40 きなく、セラミックばねを各種高温装置に使用すること ができないという問題があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このような従来技術の 間題点に鑑み、本発明の主な目的は、1000℃以上の 高温の雰囲気でも強度低下せずかつ安定して使用可能な セラミックばね付並びにセラミックばね及びその製造方 法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】このような目的は、本発 50 とができる。

明によれば、ムライトからなるマトリクスに炭化物の微 細粒子を分散してばね材を形成したことを特徴とするセ ラミックばわ村を提供することにより達成される。特 に、前記版細粒子が、TiC、SiC. VC、NbC、 B.C. TaC. WC. HfC. Cr.C., ZrCの少 なくとも1種類以上からなると良い。また、前記セラミ ックばね材からなるセラミックばね、あるいは、ムライ トからなるマトリクスに炭化物の微細粒子を分散させた 複合競結体を製作する過程と、前記複合規結体を120 ① で以上焼結温度以下(好ましくは1200℃以上14 ○○C以下〉で熱処理する過程とを有することを特徴と するセラミックばねの製造方法を提供することにより達 成される。

7

[0006]

【作用】このように、弾性率が低くばねのようなたわみ を要求するものに適合し、かつ高温度(約1400°C) まで強度劣化しない材料としてのムライト(3A1、0, 2 S · O,) 中に微細な炭化物粒子を分散させること により、ムライトと炭化物粒子との間の熱膨張差により 残留応力が発生し、強靭化されると共に、マトリックス であるムライト結晶の粒径よりもかなり小さい粒径の炭 化物粒子がムライト結晶の粒内にも存在して、マトリッ クスを強化し、また、粒径の大きな粒子が粒界に存在し て、クラックの進行を妨げることにより強靭化し得る。 また。ムライト中に微細な炭化物粒子を分散させた複合 焼結体を所望の形状に加工し、1200℃以上締結温度 以下 (好きしくは1200℃以上1400℃以下) で熱 処理してセラミックばねを形成することにより、強度を 高め得る。

[0007]

【実施例】以下、本発明の好適実施例を詳しく説明す

【0008】本発明が適用されるセラミックばねば、高 温や腐食性ガスの雰囲気で使用されるばわとして用いる のに適するものであり、例えば、ガスターピンや固体総 料電池の高温装置に於ける熱膨張吸収用ばねとして用い **ちれる**。

【0009】上記はわの付斜としてのセラミックばわ材 は、ムライト(3A!」〇」・2S!〇」)中に微細な炭 化物粒子としてのTICを添加して作られる。例えば、 平均位径0.2μmのムライト粉末(A!,O,の含有率 71.8vt%) に、平均粒径1.30 umのT:C 粉末を所 定量配合し、アルコール中でナイロンボールを用いて2 4時間湿式混合した後、エバボレータで溶媒を抽出し、 見に真空乾燥炉を用いて乾燥させて、混合粉末を調整す る。この粉末を焼結温度1650℃で4時間、N,ガス 雰囲気中で、圧力35MPaでホットプレスして、 ムラ イト中に微細な炭化物粒子を分散させた複合焼結体を製 作する。上記焼結体から所望の形状のばねを製作するこ

【0010】なお、上記実施例では炭化物粒子としてTICを添加した場合について示したが、TICに限るものではなく、SICを用いても良い。との場合には、平均粒径0.27μmのSIC粉末を用いて、他の条件は前記と同様であって良い。さらに、ムライトと焼結過程で反応しないものであれば他の炭化物であって良く、例えば、VC、NDC、B.C、TaC、WC. HIC. CI,Cz、2rCなどを用いることができ、また、復数 種用いても良い。

【0011】とのようにして製作されたセラミックはわ 16 の機械的特性を以下に示す。まず、上記・結体から3×4×40mmのサイズの試験片を板ばねとして切り出し、炭化物粒子としてTiC・SiCを用い、各添加費が0から5~1%刻みで20~1%までの各試験片を用意する。その衰血を研削・研磨する。その現性率を3点曲げ法で測定し、硬度をビッカース硬度計で測定し、破壊じん性を、荷重49N、保持時間15秒の条件下での! F法で評価し、破壊強度を、スパン長さ30mm、クロスヘッド速度0、5mm/分の3点曲付試験で測定した。 20

【0012】ムライト草体の平均粒径は1.70μmであり、ムライト・20㎞1%TiCの平均粒径は1.1μmであり、ムライト・20㎞1%SiCの平均粒径は0.5μmであった。弾性率は、ムライト草体(約210GPa)に対して添加率の増大に伴って大きく(20㎞1%で約230GPa)なる傾向を示した。また、硬度は、添加率に依存せず、ほぼ一定(11GPa)であった。

【0013】図1に、TiCの各添加率と、破壊応力及び破壊にん性との各関係の試験結果を示す。図に示されるように、添加率の増大に伴って、破壊応力及び破壊じん性共増大し、破壊応力では、ムライト単体(331MPa)に対して、20~01%TiC添加はねが約1.23倍(408MPa)まで向上し、破壊じん性では、2.65MPa・m²¹⁴かち3.88MPa・m²¹⁴まで約1.46倍向上した。図2は、SiCの各添加率に対する図1と同様の図である。この場合には、添加率の増大に伴って、破壊じん性はそれ程大きく変化しなかったが、破壊応力は、増大し、20~01%SiC添加ばわが約1.68倍(556MPa)まで向上した。

【0014】炭化物粒子の添加率の増大に伴って強度が 増大するのは、ムライト中に微細な炭化物粒子を分散さ せることにより、ムライトと炭化物粒子との間の熱膨張 菱により残固に力が発生して強靭化されると共に、マト リックスであるムライト結晶の粒径よりもかなり小さい 粒径の炭化物粒子がムライト結晶の粒内に存在してマト リックスを強化し、また、粒径の大きな粒子が粒界に存 在してクラックの進行を妨げることにより強靭化される と考えられる。

【0015】なお、上記試験結果から、炭化物添加率

は、1~30 vo1%の範囲内で、目的に合わせて変化させると良い。添加率の増加に伴って強靭化するが、現態率も増加するため、目的に合わせて添加費を選定する必要がある。いずれにしても、高温や腐食性ガス雰囲気で使用可能なセラミックばねの材料として適する。

【0016】次に、上記接合境結体を熱処理してセラミックばねを製造する場合について図3を参照して以下に示す。

【①①17】前記したように、ムライト原料粉末と炭化物(T・CあるいはS・C粉末)とを前記と同様に湿式混合し(ステップST1)した後、エバボレータで溶媒を抽出してから真空乾燥炉を用いて乾燥して混合粉末を調整し、その粉末を前記と同様にホットプレスして復合焼結体を製作し(ステップST2)。その焼結体を研削及び研磨による機械加工にて前記と同形状の3×4×40mmのサイズの試験片をばわ片として製作する(ステップST3)。そのはわ片を、大気中で例えば1300℃の温度で1時間熱処理する(ステップST4)。

【0018】図4に、上記条件で熱処理を行ったばわ片 のSiCの各添加率と破壊応力との関係の試験結果を示 す。図には、ムライト単体と、平均粒径0.27μmの SiC粉末を用いた場合と、平均粒径1.20μmのS +C粉末を用いた場合との各場合について、それぞれ上 記熱処理の実施の有気に分けて示している。

【0019】図から分かるように、ムライト単体の場合には、熱処理による破壊応力の向上がほとんど認められないが、ムライト/S・C複合体の場合には、上記熱処理を行うことにより破壊応力が善しく向上した。特に、SiCを20vol%添加した場合には、熱処理を行わなかった場合の約800MPaから約800MPaまで増大し、約30%向上した。

【0020】また、図5及び図6に、平均粒径0.27μmのSIC粉末を用いた場合と、平均粒径1.20μmのSIC粉末を用いた場合との各場合について、それでれ1200℃で2時間、1300℃で1時間、1400℃で0.5時間の熱処理を行った場合のSICの名添加率と3点曲け破壊試験による曲け強さとの関係の試験結果を示す。なお、図5の平均粒径0.27μmのSIC粉末を用いた場合には1300℃で5時間の熱処理を行った場合についても示している。

【0021】図5及び図6に示されるように、それぞれ SiC粉末を20vol%添加した場合に曲け強さが高 く、1300℃で1時間の熱処理を行った場合に最も強 度が向上した。また、熱処理温度の上限としては、焼結 温度(本実施例では1650℃)以下であれば良いが、 好ましくは真随例で示した1400℃以下である。

[0022]

【発明の効果】とのように本発明によれば、高温強度待性に係れ1400℃まで強度劣化せず、かつばねのようのに対するように低い弾性率を有

19

するが、強度自体及び破壊じん性値がそれ程大きくないムライトを、微細な炭化物粒子の添顔により、強度・じん性を向上できるため、従来に対してより一層高温の存留気で使用可能なセラミックばねを製作できる。さらに、ムライトに炭化物を分散させた複合焼結体を1200℃以上投稿温度以下(好ましくは1200℃以上1400℃以下)で熱処理してセラミックばねを製作することにより、破壊応力や曲げ強さが向上し、より一層好適なセラミックばねを得られる。

5

【図面の簡単な説明】

【図1】T・Cの添加率に対する破壊応力及び破壊しん※

*性の基関係を示す図。

【図2】SiCの添加率に対する破壊能力及び破壊じん 性の各関係を示す図。

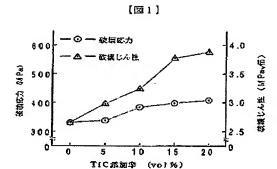
【図3】 本発明に基づくセラミックばねの製作工程を示すフロー図。

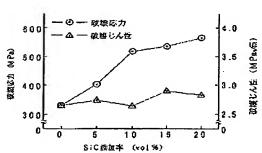
【図4】S:Cの添加率に対する破壊広力の関係を示す図。

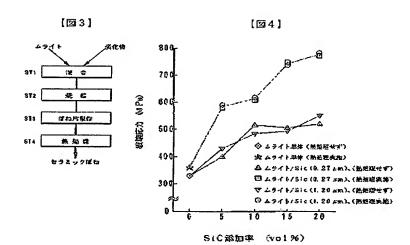
【図5】平均粒径 $0.27\mu m$ のSiCの添加率に対する曲け強さの関係を示す図。

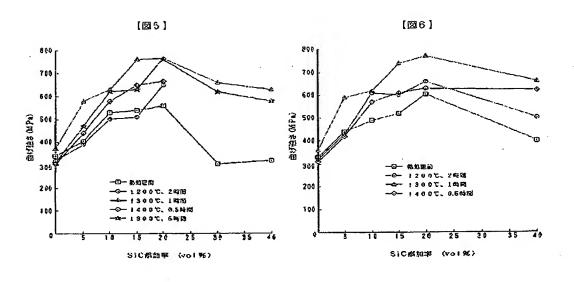
【図6】平均粒径1.20μmのSiCの添加率に対する曲け強さの関係を示す図。

[図2]









フロントページの続き

(51) Int.Cl.* H O 1 M 8/12 FI

技術表示應所

(72)発明者 安藤 柱 神奈川県藤沢市藤ヶ岡3-21-3